NANOPHYSIQUE INTRODUCTION PHYSIQUE AUX NANOSCIENCES

3. AMAS OU AGREGATS ATOMIQUES

James Lutsko

2021-2022

AMAS OU AGREGATS ATOMIQUES

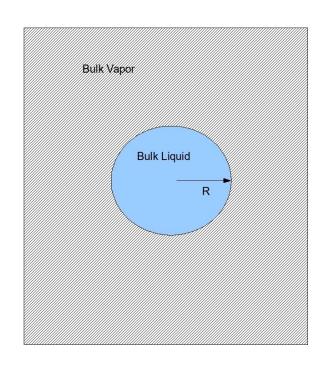
• L'auto-assemblage: Nucleation

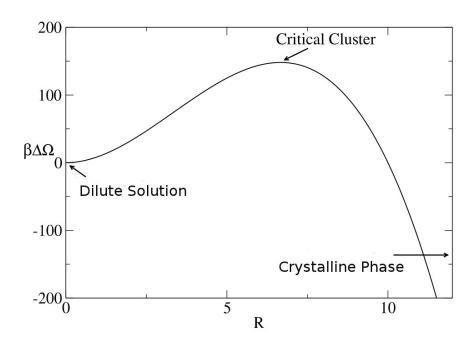
- Modele de l'amas: "capillary model".
- Thermodynamics
- Becker-Doring model
- Zeldovich equation
- Taux de nucléation

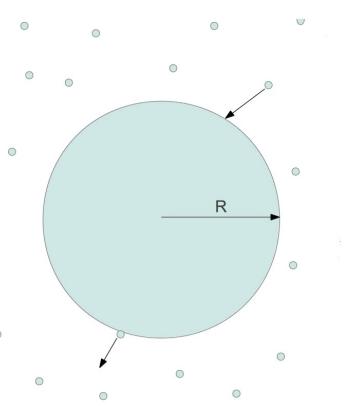
Nanoparticules cristalline

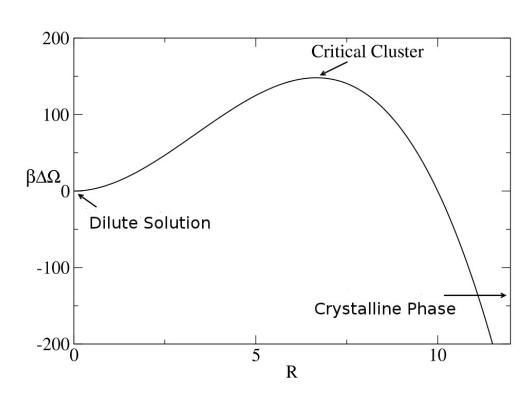
- Structure cristalline
- Indices de Miller
- Tension de surface
- Forme des Cristaux
- Transistions de phase
- Proprietes electronique des agregats

Les transitions de phase : le processus

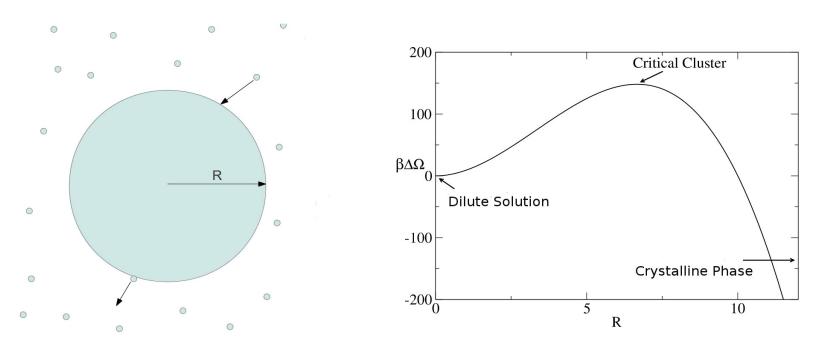








$$\begin{split} &\Omega \!=\! V(R) \omega_2 \!+\! S(R) \gamma \!+\! (V \!-\! V(R)) \omega_1 \\ &=\! V(R) \Delta \omega \!+\! S(R) \gamma \!+\! V \omega_1 \\ &\Delta \Omega \!=\! V(R) \Delta \omega \!+\! S(R) \gamma \end{split}$$



Monomer attachment/detachment (Becker-Doring c. 1930):

$$\frac{dc_n}{dt} = (f_{n-1}c_{n-1}c_1 - g_nc_n) - (f_nc_nc_1 - g_{n+1}c_{n+1})$$

 f_n, g_n sont les taux de fixation et de détachement des monomères

Monomer attachment/detachment (Becker-Doring c. 1930):

$$\frac{dc_n}{dt} = (f_{n-1}c_{n-1}c_1 - g_nc_n) - (f_nc_nc_1 - g_{n+1}c_{n+1})$$

Si l'on developper pour $n \gg 1$, $c_n(t) \rightarrow c(n,t)$ etc.

$$f(n-1)=f(n)-f'(n)+\frac{1}{2}f''(n)+...$$

on se trouve

$$\frac{dc(n,t)}{dt} = \frac{\partial}{\partial n} \left(|g(n) - f(n)| c(n,t) + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial n} |f(n) + g(n)| c(n,t) + \dots \right)$$

"Tunitskii equation"

Monomer attachment/detachment (Becker-D'oring c. 1930): Si l'on demande aussi la condition de bilan détaillé ("detailed balance"),

$$f(n)e^{-\beta\Delta\Omega(n)} = g(n+1)e^{-\beta\Delta\Omega(n+1)}$$

est developpe comme

$$g(n) = f(n-1)e^{\beta\Delta\Omega(n) - \beta\Delta\Omega(n-1)}$$

$$= f(n) - \frac{\partial f(n)}{\partial n} + f(n)\frac{\partial \beta\Delta\Omega(n)}{\partial n} + \dots$$

on trouve une resultat trés connu, l'equation de Zeldovich (1942):

$$\frac{dc(n,t)}{dt} = \frac{\partial}{\partial n} \left(-f(n) \frac{\partial \beta \Delta \Omega}{\partial n} + f(n) \frac{\partial}{\partial n} \right) c(n,t)$$

Notez qu'il semble un équation de type Fokker-Planck.

Classical Nucleation Theory (CNT): Nucleation rates

Si l'on commence avec une solution de monomères, éventuellement un cristal sera nucléée et il va consommer les monomères. C'est une

processus pas soutenu. Mais, si l'on ajouter des monomères est si l'on enleve des amas post-critique, on peut faire une état stationairre. Dans ce cas, la solution de l'equation Zeldovich est facile:

$$0 = \frac{dc(n,t)}{dt} = \frac{\partial}{\partial n} \left(-f(n) \frac{\partial \beta \Delta \Omega}{\partial n} + f(n) \frac{\partial}{\partial n} \right) c(n,t)$$

$$J = -f(n) \frac{\partial \beta \Delta \Omega}{\partial n} c(n,t) + f(n) \frac{\partial}{\partial n} c(n,t)$$
$$= -f(n) e^{-\beta \Delta \Omega} \frac{\partial}{\partial n} e^{\beta \Delta \Omega} c(n,t)$$

$$c(n) = A e^{-\beta\Delta\Omega(n)} + B e^{-\beta\Delta\Omega} \int_{1}^{n} e^{\beta\Delta\Omega(n')} / f(n') dn'$$

Alors, car c (n*) = 0, la solution est
$$c(n) = B e^{-\beta \Delta \Omega} \int_{n}^{n^*} e^{\beta \Delta \Omega(n')} / f(n') dn'$$

Classical Nucleation Theory (CNT): Nucleation rates

On peut écrire le résultat comme

$$c(n) = c(1)e^{-\beta(\Omega(n) - \Omega(1))} \int_{n}^{n^{*}} e^{\beta\Delta\Omega(n')} / f(n') dn' / \int_{1}^{n^{*}} e^{\beta\Delta\Omega(n')} / f(n') dn'$$

$$\frac{dc(n,t)}{dt} = \frac{\partial}{\partial n} \left(-f(n) \frac{\partial \beta\Delta\Omega}{\partial n} + f(n) \frac{\partial}{\partial n} \right) c(n,t) \equiv \frac{\partial}{\partial n} J(n)$$

$$\frac{d}{dt} \int_{1}^{n^{*}} c(n,t) dn = \underbrace{J(n^{*})}_{\text{rate removed}} - \underbrace{J(1)}_{\text{rate added per unit volume}}$$

Rate removed per unit volume == rate of formation of critical clusters

Classical Nucleation Theory (CNT): Nucleation rates

On peut écrire le résultat comme

$$c(n)=c(1)e^{-\beta(\Omega(n)-\Omega(1))}\int_{n}^{n^{*}}e^{\beta\Delta\Omega(n')}/f(n')dn'/\int_{1}^{n^{*}}e^{\beta\Delta\Omega(n')}/f(n')dn'$$

La taux est simplement la flux:

$$J(n^*) = \left(f(n)e^{-\beta\Delta\Omega}\frac{\partial}{\partial n}e^{\beta\Delta\Omega}c(n,t)\right)_{n^*} = c(1)\left(\int_{1}^{n^*}e^{\beta\Delta\Omega(n)}/f(n)dn\right)^{-1}$$

Un évaluation par "steepest descent" donne le resultat

$$J \approx c_1 f(n^*) \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \sqrt{|\Delta \beta \Omega''(n^*)|} \exp(-\Delta \beta \Omega(n^*))$$

Monomer attachment frequency: Diffusion-limited growth

La taux de fixation de monomères est évidemment determiné par la taux auquel les monomères frappe la surface Pour ca, on suppose que le mouvement des momomères est par la processus de diffusion. Donc,

$$\frac{\partial c_1}{\partial t} = D \nabla^2 c_1 = D \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r c_1$$

On suppose que il y a un état de quasi-equilibre,

$$\frac{\partial c_1}{\partial t} = 0 = D \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r c_1 \rightarrow c_1(r) = c_1(\infty) + \frac{a}{r}$$

Si chaque molécule qui arrive est fixé, la condition à la limite est c(R) = 0 de sorte que

$$c_1(r) = c_1(\infty) \left(1 - \frac{R}{r}\right)$$

Monomer attachment frequency: Diffusion-limited growth

Parce-que on a une état stationnaire, la nombre total des monomères dans la volume total est constant:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{V} c_{1}(r;t) d\mathbf{r} = D \int_{V} \nabla^{2} c_{1} d\mathbf{r}$$

$$=D\left(S(R_{max})c'_{1}(R_{max})-S(R)c'_{1}(R)\right)$$

Donc, la nombre fixé sur la surface par unité de temps est simplement DS(R)c'(R) de sorte que

$$\begin{split} f_n &= f(R(n)) & c_1(r) = c_1(\infty)(1 - \frac{R}{r}) \\ &= D 4 \pi R^2(n) c_1'(R) \\ &= D 4 \pi R(n) c_1(\infty) & c'_1(r) = c_1(\infty) \frac{R}{r^2} \end{split}$$

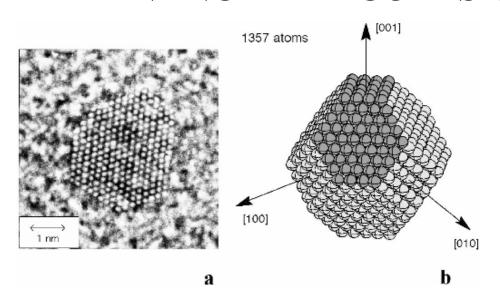
AMAS OU AGREGATS ATOMIQUES

- L'auto-assemblage: Nucleation
 - Modele de l'amas: "capillary model".
 - Thermodynamics
 - Becker-Doring model
 - Zeldovich equation
 - Taux de nucléation

Nanoparticules cristalline

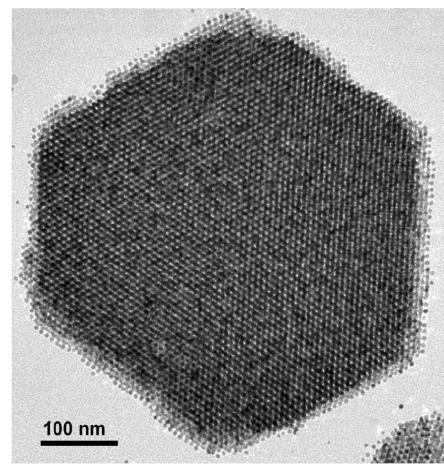
- Structure cristalline
- Indices de Miller
- Tension de surface
- Forme des Cristaux
- Transistions de phase
- Proprietes electronique des agregats

NANOPARTICULES CRISTALLINES



Co nanoparticle

M. Jamet et al., Phys. Rev. Lett. **86** (2001) 4676



CoPt₃ nanoparticle

Shevchenko, O'Brien, Murray (Columbia, IBM)

Structure des cristaux

Structure: Réseau Bravais avec une ou plusieurs molécules positionné par rapport au point du réseau.

Les point du réseau sont donnés comme:

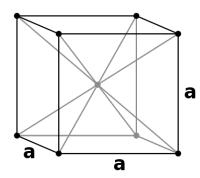
$$\mathbf{R}_{1} = \mathbf{n}_{1} \mathbf{a}_{1} + \mathbf{n}_{2} \mathbf{a}_{2} + \mathbf{n}_{3} \mathbf{a}_{3}$$

ou {a_i} sont les vecteur de bases du réseau est {n_i} sont des nombres entiers.

a

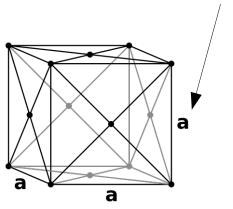
Simple Cubic $(N_{nn}=6)$

Cellule unitaire



Body-Centered Cubic (N_{nn}=8)

paramètre du réseau



Face-Centered Cubic $(N_{nn}=12)$

Structure des cristaux (suite)

Réseau réciproque : tous les vecteurs d'onde qui sont périodique sur le réseau :

$$\exp(i \mathbf{K}_{j} \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{R}_{l})) = \exp(i \mathbf{K}_{j} \cdot \mathbf{r}) \rightarrow \mathbf{K}_{j} \cdot \mathbf{R}_{l} = 2\pi n \delta_{jl}, \qquad n \in \mathbb{Z}$$

Il s'ensuite que
$$\mathbf{K} = \sum_{j=1}^{d} m_j \mathbf{b}_j$$

ou
$$\boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{b}_j = 2 \pi \delta_{ij} \rightarrow \boldsymbol{b}_1 = 2 \pi \frac{\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3}{\boldsymbol{a}_1 \cdot (\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3)}$$

Théorème: pour chaque famille de plans du réseau séparés par une distance "d", il ya des vecteurs du réseau réciproque perpindicular les plans et la plus courte a une longueur de $2\pi/d$.

(Apres Mermin and Ashcroft, "Solid State Physics", Holt, Reinhard and Winston, 1976, PA.)

Preuve:

Si la normale aux plans est \hat{n} , la vecteur $K=2\pi \hat{n}/d$ est dans la réseau réciproque:

Parce-que si $\mathbf{R}_i \in \text{plane } m_i \text{ et } \mathbf{R}_j \in \text{plane } m_j$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{K} \cdot \boldsymbol{R}_{i} &= \boldsymbol{K} \cdot \boldsymbol{R}_{j} + \boldsymbol{K} \cdot \left(\boldsymbol{R}_{i} - \boldsymbol{R}_{j} \right) \\ &= \boldsymbol{K} \cdot \boldsymbol{R}_{j} + \boldsymbol{K} \cdot \left\{ \left(\boldsymbol{m}_{i} - \boldsymbol{m}_{j} \right) d \, \hat{\boldsymbol{n}} + \left(\boldsymbol{R}_{i} - \boldsymbol{R}_{j} \right)_{\text{perp}} \right\} \\ &= \boldsymbol{K} \cdot \boldsymbol{R}_{j} + 2 \, \pi \left(\boldsymbol{m}_{i} - \boldsymbol{m}_{j} \right) \end{aligned}$$

$$\rightarrow \mathbf{K} \cdot (\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j) = \mathbf{K} \cdot \mathbf{R}_l = 2\pi (m_i - m_j)$$
 Difference of two lattice vectors is a lattice vector

$$\rightarrow \exp(i \mathbf{K} \cdot \mathbf{R}_l) = \exp(i 2\pi(m_i - m_j)) = 1$$

Les indices de Miller d'un plan du réseau sont les coordonnées du <u>plus petit vecteur du</u> <u>réseau réciproque qui soit normal à ce plan</u>, par rapport à un ensemble spécifié de vecteurs de bases. Un plan d'indices de Miller (h,k,l) est donc normal au vecteur du réseau réciproque:

$$K = h b_1 + k b_2 + l b_3, (h, k, l)$$

des entiers sans facteur commun

Alternative:

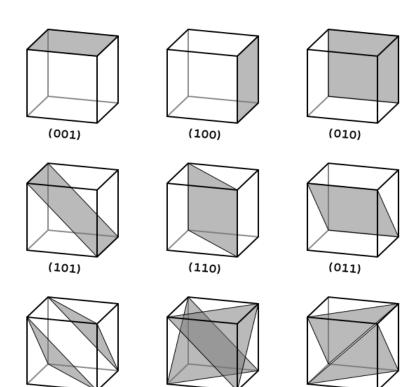
$$\boldsymbol{b}_{i} \cdot \boldsymbol{a}_{j} = 2 \pi \delta_{ij}$$

Eq. pour plane $K \cdot r = A$

$$r = x_1 a_1 \rightarrow A = K \cdot r = x_1 K \cdot a_1 = 2 \pi x_1 h$$

donc, $h=A/x_1$, ... $k=A/x_2$... $l=A/x_3$

$$\rightarrow h: k: l = \frac{1}{x_1}: \frac{1}{x_2}: \frac{1}{x_3}$$



 $(1\bar{1}1)$

 $(\bar{1}11)$

(111)

Les intersections avec les axes sont:

$$h:k:l=\frac{1}{x_1}:\frac{1}{x_2}:\frac{1}{x_3} \rightarrow \frac{h}{k}=\frac{x_2}{x_1}, \frac{h}{l}=\frac{x_3}{x_1}$$

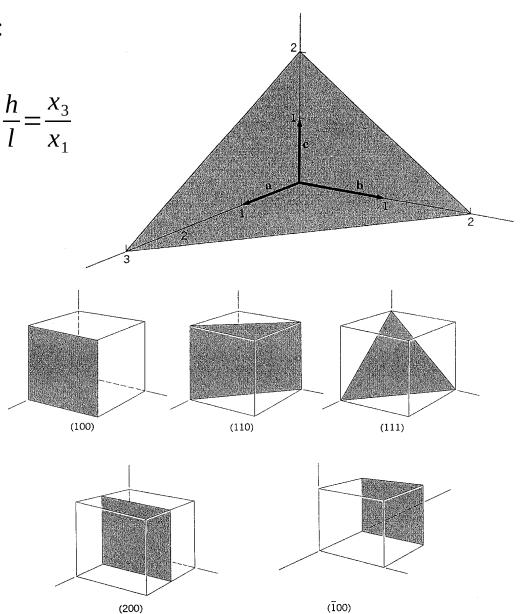
Example

$$x_1 = 3, x_2 = 2, x_3 = 2$$

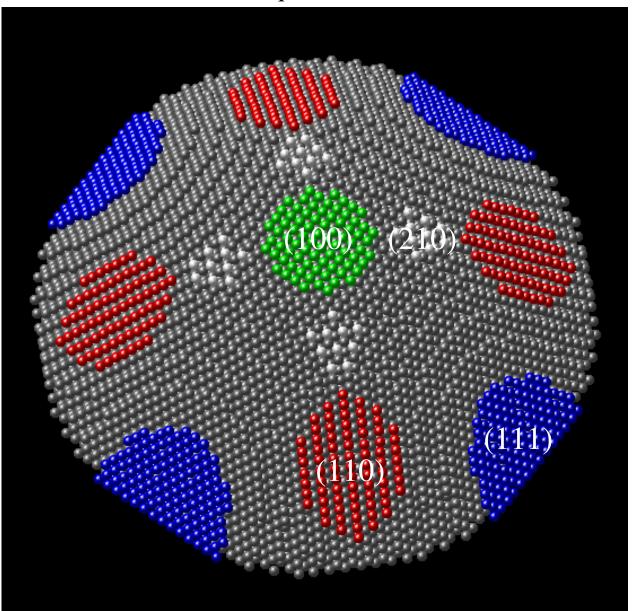
$$x_1 = 3, x_2 = 2 \rightarrow \frac{h}{k} = \frac{2}{3} \rightarrow 3h = 2k$$

$$x_1 = 3, x_3 = 2 \rightarrow \frac{h}{l} = \frac{2}{3} \rightarrow 3h = 2l$$

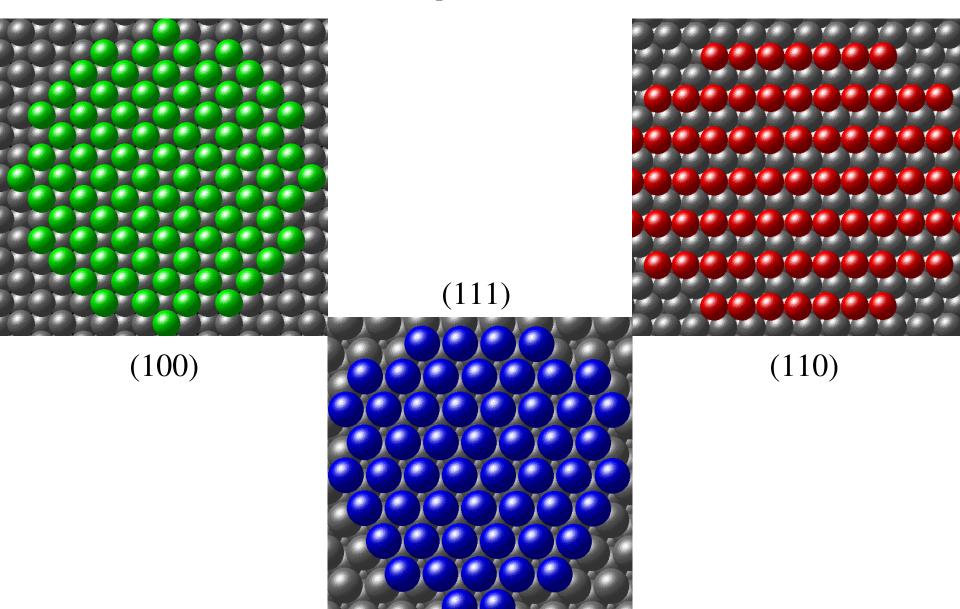
$$\rightarrow$$
 (hkl)=(2,3,3)



cristal cubique faces centrées



cristal cubique faces centrées



Surfaces: Propriétés

Souvent, la propriété la plus importante de surfaces différentes sont leurs densités.

Volume du cellule unitaire: $V = |\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)|$

Densité des pointes sur un plan de réseau: $\sigma = d/v$

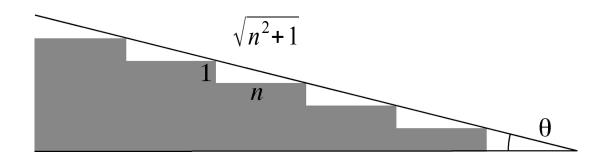
Les plus denses plans:

FCC: (111)

BCC: (110)

SC: (100)

Tension de Surface: Anisotropie



Energie d'un atome de terrace: a

Energie d'un atome de marche: b

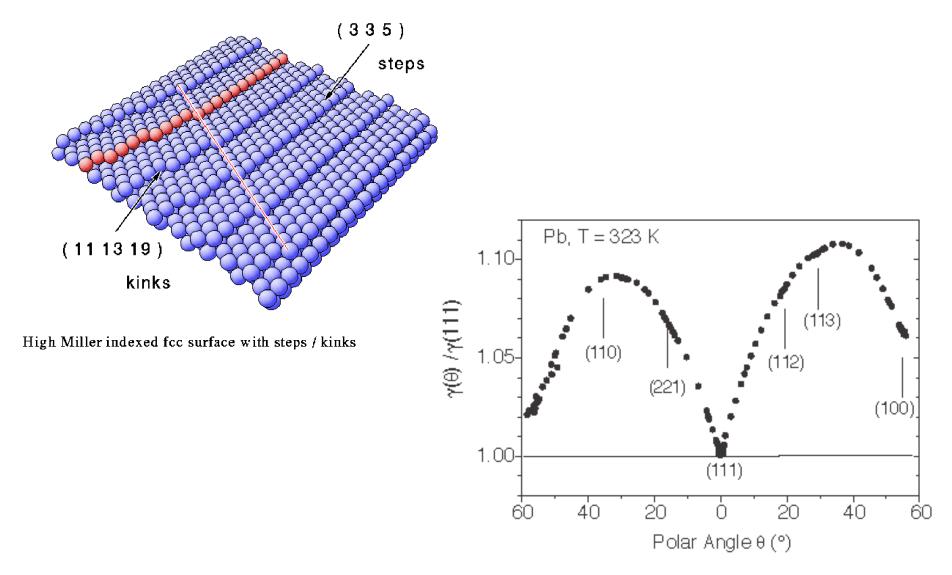
Energie par unité de surface: $y = \frac{an+b}{\sqrt{n^2+1}}$

$$\gamma = \frac{an+b}{\sqrt{n^2+1}}$$

Angle entre le plan de surface et les terraces:
$$\theta = \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} = \sin \theta$$

Tension superficielle: $\gamma(\theta) = a \cos \theta + b |\sin \theta|$

Tension de Surface: Anisotropie



H. P. Bonzel, 3D equilibrium crystal shapes in the new light of STM and AFM, Phys. Rep. 385 (2003) 1-67

Forme des Cristaux

La forme d'un cristal est celle qui minimise l'énergie de surface

(Curie, 1885; Wulff, 1901).

Energie libre:
$$dF = -P_{\text{fluid}} dV_{\text{fluid}} - P_{\text{crystal}} dV_{\text{crystal}} + \oiint \gamma(\mathbf{n}) dA$$

conservation du volume: $dV_{\text{fluid}} = -dV_{\text{crystal}}$

$$dF = -(P_{\text{crystal}} - P_{\text{fluid}}) dV_{\text{crystal}} + \oiint \gamma(\mathbf{n}) dA = 0$$

Energie de surface minimum:

contrainte de volume constant:

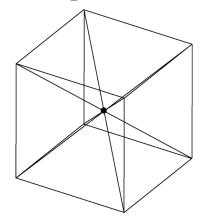
$$\min \oiint \gamma(\mathbf{n}) dA \qquad \qquad \iiint dV = \text{constant}$$

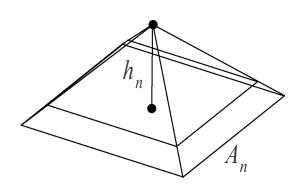
Forme des Cristaux

La forme d'un cristal est celle qui minimise l'énergie de surface

(Curie, 1885; Wulff, 1901).

Décomposition du cristal en domaines pyramidaux:





Parce-que la pyramid est autosimilaire ("self-similar") comme fonction de la distance au-dessous la point, la surface d'une section varie comme $A(h) = A(h_0) \times \left(\frac{h}{h_0}\right)^2$ indépendamment de la forme.

Donc, la volume est $\int_{0}^{h_{n}} A(z) dz = \frac{1}{3} A_{n} h_{n}$

Forme des Cristaux

La forme d'un cristal est celle qui minimise l'énergie de surface

(Curie, 1885; Wulff, 1901).

Il s'ensuite que

$$A_n(h) = A_n(h_0) h_n^2 \rightarrow \delta A_n = 2(A_n/h_n) \delta h_n$$

$$V_n = \frac{1}{3} A_n h_n \rightarrow \delta V_n = A_n \delta h_n$$

Minimisez l'énergie de la surface à volume constante:

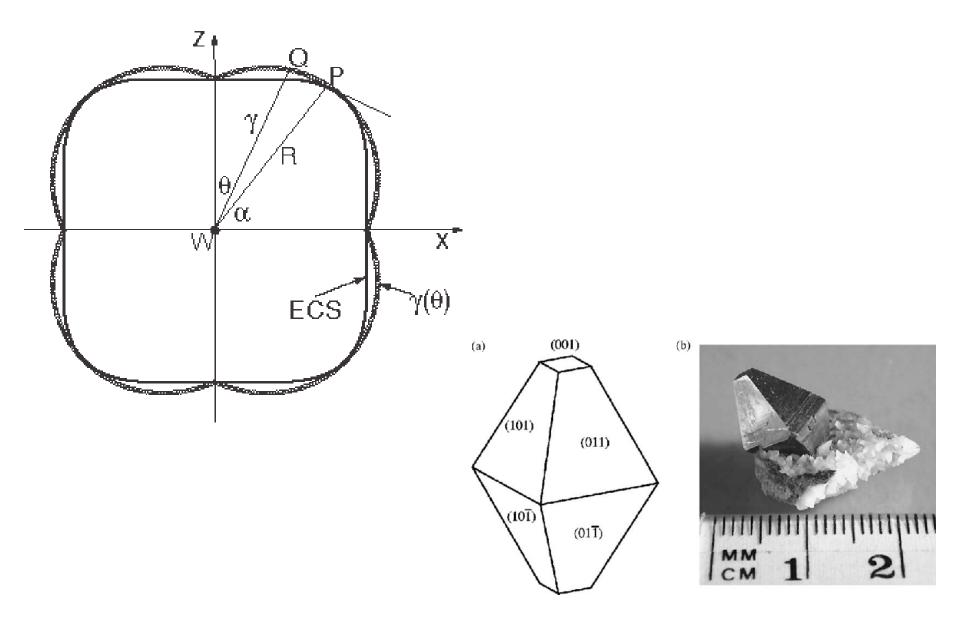
$$0 = \delta(F - \lambda(V - V_0)) = \Delta P \delta V + \sum \gamma_n \delta A_n - \lambda \delta V - \delta \lambda(V - V_0)$$

$$0 = \sum \left(\frac{2}{h} A_n \gamma_n - \lambda A_n + \Delta P A_n\right) \delta h_n + \delta \lambda(V - V_0)$$

$$0 = \sum \left(\gamma_n - \frac{(\lambda - \Delta P)}{2} h_n \right) 2 A_n \frac{\delta h_n}{h_n} + \delta \lambda (V - V_0)$$

$$\Rightarrow h_n = constant \times \gamma_n$$

Construction de Wulff(1901)



U. Diebold, The surface science of titanium dioxide, Surf. Sci. Rep. 48 (2003) 53-229

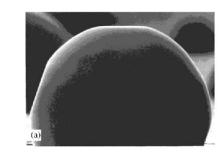
Structures d'Equilibre 3D

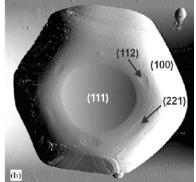
T = 0: polyhèdre avec faces planes et arêtes anguleuses

 $0 < T < T_R$: faces planes avec arêtes arrondies

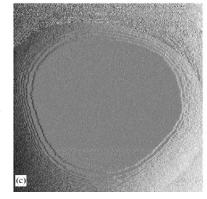
 $T_{\rm R} < T$: surface arrondie

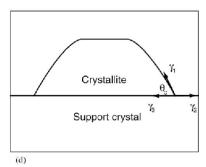
 $T_{\rm R}$: température de la transition rugueuse





- (a) cristal de Pb vu dans la direction [110], T = 300 K
- (b) Pb/Ru(001), T = 323 K, rayon des faces ~ 140 nm
- (c) cristal de Pb, T = 363 K, rayon de la face (111) ~ 230 nm





H. P. Bonzel, 3D equilibrium crystal shapes in the new light of STM and AFM, Phys. Rep. 385 (2003) 1-67

Structures d'Equilibre 3D

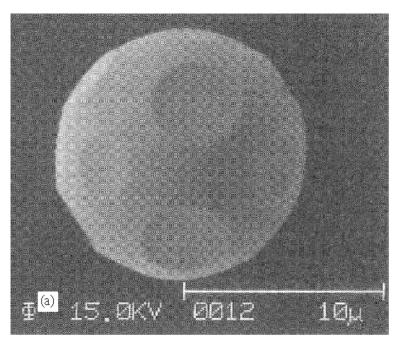
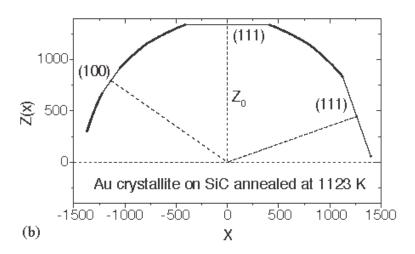
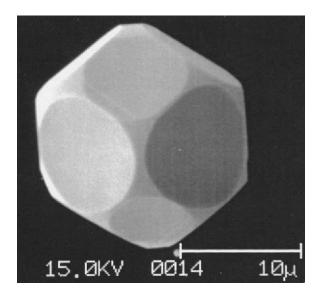


Image SEM d'un cristal de Au sur un substrat de SiC, incubation pendant 72h à T = 1123 K

Cristal d'un alliage de Ni avec 5% Pb et 0,08% Bi, à T = 548 K





H. P. Bonzel, 3D equilibrium crystal shapes in the new light of STM and AFM, Phys. Rep. 385 (2003) 1-67

Structures d'Equilibre 2D

tension de ligne (tension de surface à 1D)

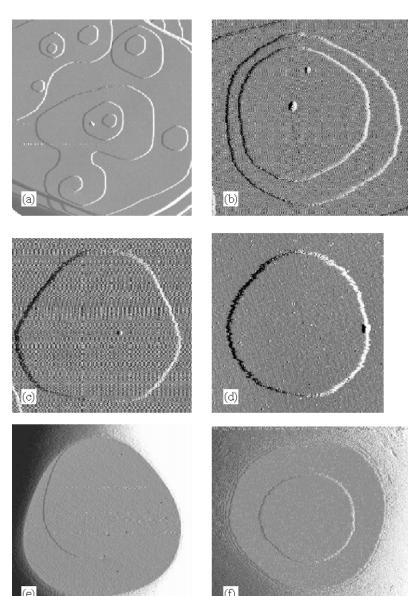
T = 0: polygone

T > 0: îlot arrondi

La température de la transition rugueuse est nulle à 2D, car il n'y a pas de transition de phase à 1D.



- (a) T = 150 K, 250 nm x 250 nm
- (b) T = 167 K, rayon de la face du dessus ~ 36 nm
- (c) T = 172 K, rayon ~ 32 nm
- (d) T = 277 K, rayon ~ 42 nm
- (e) T = 308 K, rayon ~ 280 nm
- (f) T = 323 K, rayon ~ 110 nm



H. P. Bonzel, 3D equilibrium crystal shapes in the new light of STM and AFM, Phys. Rep. 385 (2003) 1-67

Il n'y a pas de transition de phase à 1D.

Théorème: Il n'ya pas de transition de phase dans un système 1D infinie si les interactions sont à courte portée. (Landau, 1950)

Preuve (l'idée):

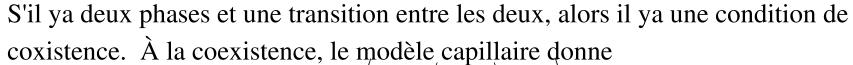
$$\Delta F = F_I - F_{II} = -4\varepsilon + k_B T \ln N > 0$$
 si N est assez grande.

Il n'y a pas de transition de phase à 1D.

Théorème: Il n'ya pas de transition de phase dans un système 1D infinie si les interactions sont à courte portée.

Preuve (Landau, 1950)

L. D. Landau, E. M. Lifshitz, Statistical Physics I (Pergamon Press, New York, (1980).



$$\Omega = L \omega + n \gamma + k_B T \left(\frac{n}{L} \ln \left(\frac{n}{L} \Lambda \right) - \frac{n}{L} \right) L$$

$$= L \omega + n \gamma + k_B T \left(n \ln(n) - n \left(1 - \ln \left(\frac{\Lambda}{L} \right) \right) \right)$$

Ce qui est nouveau, le dernier terme, est l'entropie d'une solution diluée des frontières (simplement, l'energie d'un gaz parfait). Mais,

$$\frac{\partial \Omega}{\partial n} = \gamma + k_B T \ln(n) + k_B T \ln\left(\frac{\Lambda}{L}\right) < 0, \quad \text{si } \frac{\Lambda}{L} \Rightarrow 0$$

La bord de "courte porteé" est l'inverse du carré. D. Ruelle, Comm. Math. Phys. 9:267 (1968), F. J. Dyson, Comm. Math. Phys. 12:91 (1969).